

D3 En BCC med gitterparameter  $a$  har primitiva vektorer:

$$a = \frac{a}{2} (\hat{x} + \hat{y} - \hat{z}), \quad b = \frac{a}{2} (-\hat{x} + \hat{y} + \hat{z}), \quad c = \frac{a}{2} (\hat{x} - \hat{y} + \hat{z}).$$

Basvektorerna i det reciproka gittret ges av

$$A = \frac{b \times c}{a \cdot b \times c} \cdot 2\pi, \quad B = \frac{c \times a}{a \cdot b \times c} \cdot 2\pi, \quad C = \frac{a \times b}{a \cdot b \times c} \cdot 2\pi$$

$$b \times c = \frac{a^2}{4} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{a^2}{4} (2\hat{x} + 2\hat{y} + 0\hat{z})$$

$$c \times a = \frac{a^2}{4} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \frac{a^2}{4} (0\hat{x} + 2\hat{y} + 2\hat{z})$$

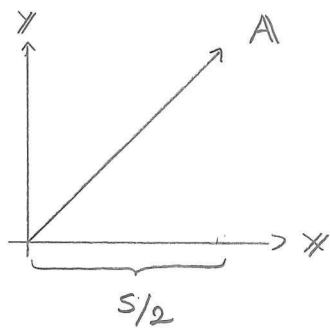
$$a \times b = \frac{a^2}{4} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{a^2}{4} (2\hat{x} + 0\hat{y} + 2\hat{z})$$

$$a \cdot b \times c = \frac{a}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \cdot \frac{a^2}{4} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{a^3}{8} (2+2) = \frac{a^3}{2}$$

Vi får nu:

$$A = \frac{2\pi}{a} (\hat{x} + \hat{y}), \quad B = \frac{2\pi}{a} (\hat{y} + \hat{z}), \quad C = \frac{2\pi}{a} (\hat{x} + \hat{z})$$

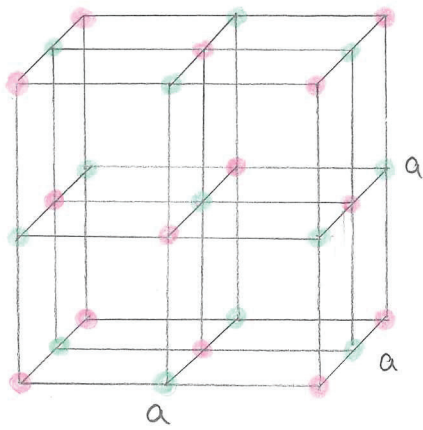
Ser att dessa vektorer bildar punkter på 3 närliggande sidor i en kub. Bestäm kantlängden  $s$ !



$$\frac{s}{2} = \frac{2\pi}{a}$$

$$\Rightarrow s = \frac{4\pi}{a}$$

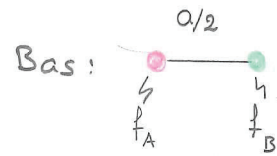
D8



Enhetscell för NaCl-struktur.

●  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Br}^-$ ●  $\text{K}^+$ 

Gitter: FCC



Vilka hkl är tillåtna för NaCl-strukturen?

Strukturfaktor:  $S_{hkl} = \sum_i f_i e^{i\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{G}_{hkl}}$

Vi studerar basen  $\mathbf{r}_A = (0,0,0)$ ,  $\mathbf{r}_B = (\frac{1}{2}, 0, 0) \cdot a$ 

$$\mathbf{G}_{hkl} = \frac{2\pi}{a} (h, k, l)$$

$$\Rightarrow S_{hkl} = f_A e^{i \cdot (0,0,0) \cdot (2\pi h, 0, 0) \frac{a}{a}} + f_B e^{i \cdot (\frac{1}{2}, 0, 0) \cdot (2\pi h, 0, 0) \frac{a}{a}} = f_A + f_B e^{i \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\pi}$$

Om  $f_A \neq f_B \Rightarrow S_{hkl} \neq 0 \forall h$

Om  $f_A = f_B \Rightarrow S_{hkl} = 0$  för h udda ( $e^{i\pi} = \cos\pi + i\sin\pi = -1 + 0i$ )

Slutsats: Om atomspredningsfaktorena  $f_i$  är lika stora

och h är udda så kommer strukturfaktorn bli noll,

och ingen reflexion kommer att uppstå. Skillnaden mellan

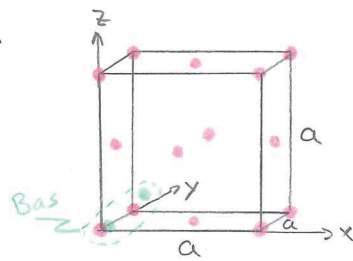
resultaten beror uppenbarligen på att

$$f_{\text{K}^+} \neq f_{\text{Br}^-} \quad \text{och} \quad f_{\text{K}^+} \approx f_{\text{Cl}^-}$$

① 13 Si och GaAs har FCC-gitter.

► Si:  $r_1 = (0,0,0)a$ ,  $r_2 = (1/4, 1/4, 1/4)a$

► GaAs:  $r_1 = (0,0,0)a$ ,  $r_2 = (1/4, 1/4, 1/4)a$



De tillåtna reflexerna uppkommer då  $S \neq 0$ . Hitta de plan som gör att struktur faktorn  $S = 0$

$$S = \sum_j f_j e^{-i \Delta k \cdot r_j} = \sum_j f_j e^{-i G_{hkl} \cdot r} = 0$$

$$G_{hkl} = \frac{2\pi}{a} (h, k, l)$$

$$\Rightarrow f_1 e^{-i \frac{2\pi}{a} (h,k,l) (0,0,0)} + f_2 e^{-i \frac{2\pi}{a} (h,k,l) (1/4, 1/4, 1/4)a} = 0$$

Si

$$f_{Si} (1 + e^{-i\pi \cdot \frac{1}{2}(h+k+l)}) = 0$$

$$\Rightarrow 1 + \cos \frac{\pi}{2} (h+k+l) - i \sin \frac{\pi}{2} (h+k+l) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} (h+k+l) = \pi + n \cdot 2\pi$$

$$\Rightarrow \boxed{h+k+l = 2 + 4n} \quad \text{111} \quad \cancel{200} \quad 220 \quad 311 \quad \dots$$

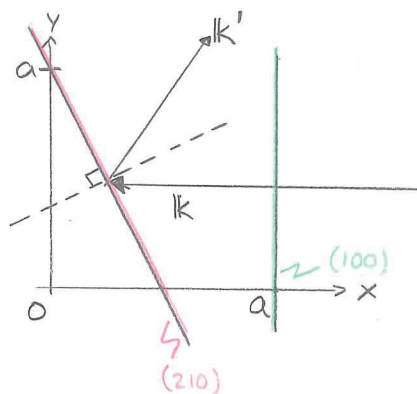
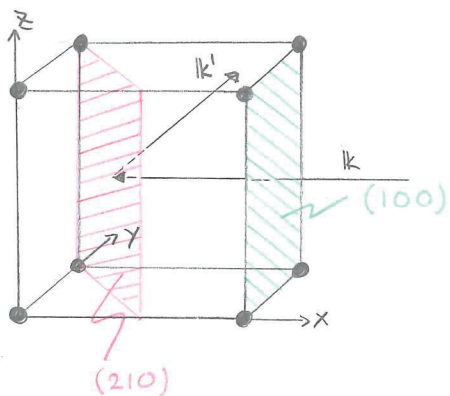
GaAs

$$f_{Ga} + f_{As} e^{-i \cdot \pi \cdot \frac{1}{2}(h+k+l)} = 0$$

Eftersom  $f_{Ga} \neq f_{As}$  blir struktur faktorn alltid nollskild.

$$\Rightarrow \boxed{\text{Alla FCC-reflexer}} (h,k,l \text{ udda eller } h,k,l \text{ jämna}) \text{ erhålls.}$$

114



- ▶ Vid diffraction är  $k' - k = \Phi$ , där  $\Phi$  är (210)-planets reciproka gittervektor.

$$\Phi_{hkl} = \frac{2\pi}{a}(h, k, l) \Rightarrow \Phi_{210} = \frac{2\pi}{a}(2, 1, 0)$$

$$k = (-k, 0, 0) \text{ , ty infaller rakt mot planet } (100)$$

- ▶ Vi kan nu beräkna  $k'$  :

$$k' = \Phi_{210} + k = \left( \frac{4\pi}{a} - k, \frac{2\pi}{a}, 0 \right)$$

- ▶ För att beräkna storleken på  $|k|$  används  $|k| = |k'|$

$$|k'| = \sqrt{\left(\frac{4\pi}{a} - k\right)^2 + \left(\frac{2\pi}{a}\right)^2} = \sqrt{\frac{16\pi^2}{a^2} - \frac{8\pi k}{a} + k^2 + \frac{4\pi^2}{a^2}} = k' = k$$

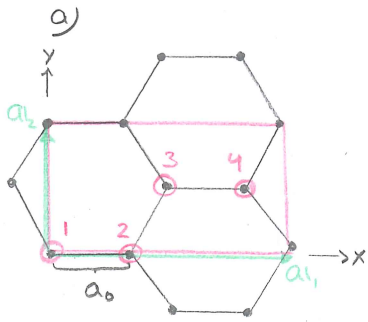
$$\Rightarrow \cancel{k^2} = \frac{16\pi^2}{a^2} - \frac{8\pi k}{a} + \cancel{k^2} + \frac{4\pi^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow \frac{8\pi k}{a} = \frac{20\pi^2}{a^2}$$

$$\Rightarrow k = \frac{20\pi}{8a} = \frac{5\pi}{2a}$$

$\therefore |k| = \frac{5\pi}{2a}$  ger diffraction vid reflektion mot (210)

D24 Elektroner infallande vinkelrätt mot ett lager grafit (grafen)



$$\begin{cases} a_1 = 3a_0 \hat{x} \\ a_2 = \sqrt{3}a_0 \hat{y} \end{cases}$$

Bas: 
$$\begin{cases} r_1 = 0a_1 + 0a_2 \\ r_2 = 1/3 a_1 \\ r_3 = 1/2 a_1 + 1/2 a_2 \\ r_4 = 5/6 a_1 + 1/2 a_2 \end{cases}$$

b) Diffraction

$$\begin{cases} b_1 \cdot a_1 = 2\pi \\ b_1 \cdot a_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow b_1 = \frac{2\pi}{3a_0} \hat{x}$$

$$\begin{cases} b_2 \cdot a_2 = 2\pi \\ b_2 \cdot a_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow b_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{3}a_0} \hat{y}$$

► Strukturfaktor för basen:

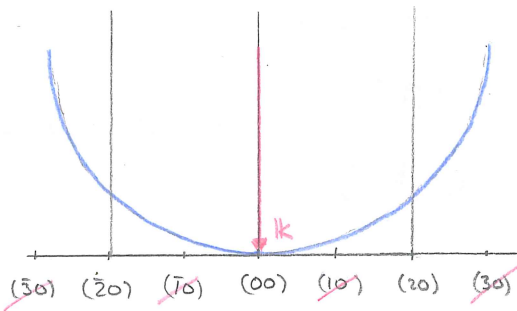
$$S_G = \sum_j f_j e^{-iG \cdot r_j} = \{ \text{Bara kolatomer} \} = f \sum_{j=1}^4 e^{-iG \cdot r_j}$$

Med  $G = hb_1 + kb_2$

$$\Rightarrow S_{hk} = f \left( 1 + e^{-i\frac{2\pi}{3}h} + e^{-i\pi(h+k)} + e^{-i(\frac{5\pi}{3}h + \pi k)} \right) =$$

$$= f \left( 1 + e^{-i\pi(h+k)} \right) \left( 1 + e^{-i\frac{2\pi}{3}h} \right) \quad \because h+k \text{ udda} \Rightarrow S_{hk} = 0$$

► Ewaldsfärkonstruktion  $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = 4,07 \cdot 10^{10} \text{ m}^{-1}$



Intilliggande stavar (närmaste)

har avstånd  $2/|b_1| = \frac{4\pi}{3a_0}$

$$\cos \Theta = \frac{2/|b_1|}{k} = \frac{\frac{4\pi}{3a_0}}{4,07 \cdot 10^{10}} = 43,5^\circ$$

$$\Rightarrow \alpha = \Theta + 90^\circ = \underline{\underline{133,5^\circ}}$$

